



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

**HB688**

对应国外型号  
2SB688

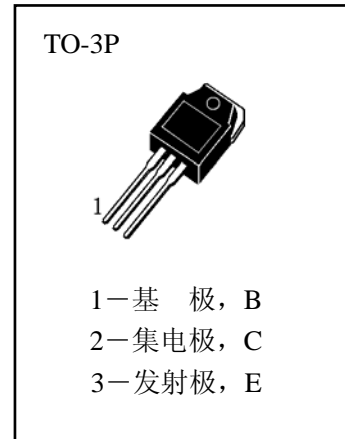
■ 主要用途

音频功率放大。与 HD718 互补。

■ 极限值 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

$T_{stg}$	— 贮存温度	.....	-55~150 $^\circ\text{C}$
$T_j$	— 结温	.....	150 $^\circ\text{C}$
$P_C$	— 集电极功率耗散 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	.....	80W
$V_{CBO}$	— 集电极—基极电压	.....	-160V
$V_{CEO}$	— 集电极—发射极电压	.....	-140V
$V_{EBO}$	— 发射极—基极电压	.....	-6V
$I_C$	— 集电极电流 (DC)	.....	-10A
$I_B$	— 基极电流	.....	-1A

■ 外形图及引脚排列



■ 电参数 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	-140			V	$I_C=-5\text{mA}, I_B=0$
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			-10	$\mu\text{A}$	$V_{CB}=-140\text{V}, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			-10	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=-6\text{V}, I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	55		160		$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-1\text{A}$
$H_{FE}(2)$		35				$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-4\text{A}$
$V_{BE}$	基极—发射极电压			-1.5	V	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-5\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-2.0	V	$I_C=-6\text{A}, I_B=-0.6\text{A}$
$f_T$	特征频率		30		MHz	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-1\text{A}$
$C_{ob}$	共基极输出电容		260		pF	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$

■ HFE (1) 分档及其标志

R

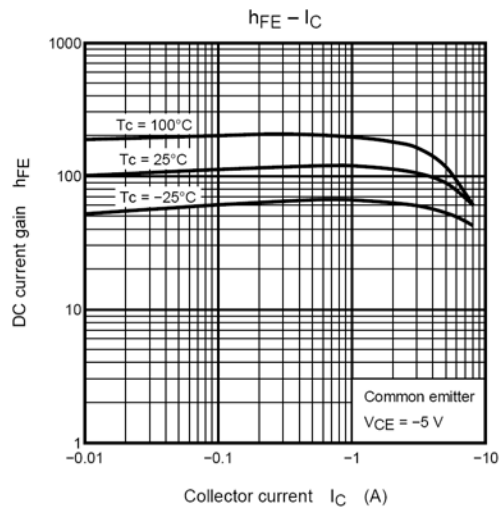
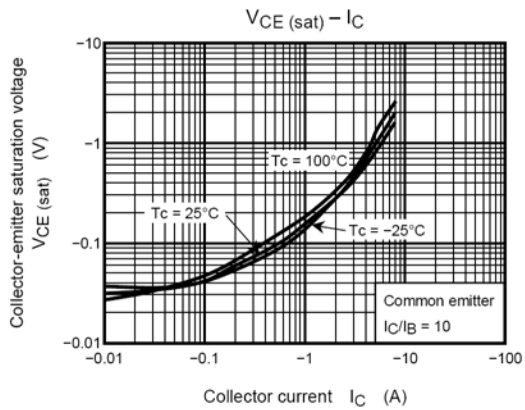
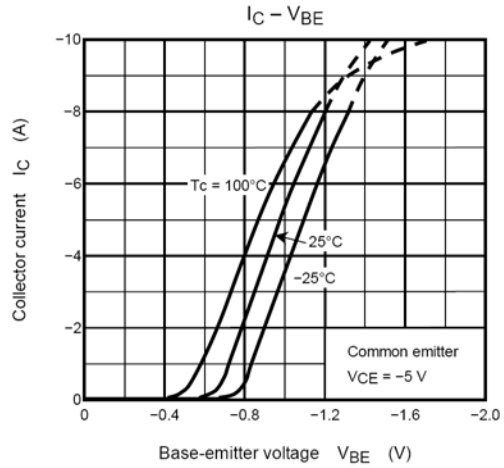
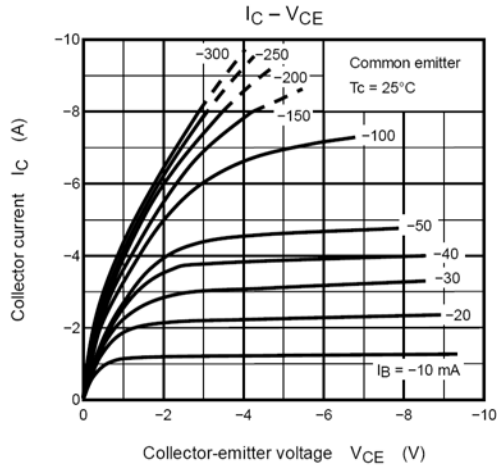
0

55—110

80—160



■ 典型特性曲线



Safe Operating Area (Single Pulse)

